



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

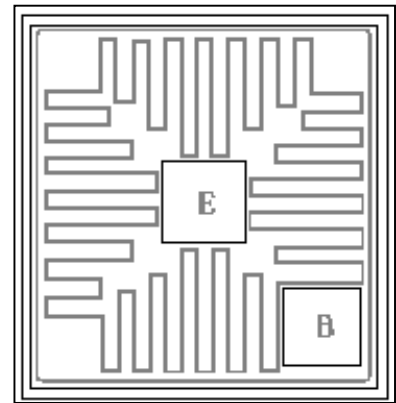
HD965

对应国外型号
2SD965

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
 芯片代码：C089AJ-00-XXX
 芯片厚度：240 ± 20μm
 管芯尺寸：890 × 890μm²
 焊位尺寸：B 极 230×230μm；E 极 170×170μm
 电极金属：铝
 背面金属：金
 封装形式：TO-92

芯片图



极限值 (T_a=25)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温..... 150
 P_C——集电极耗散功率.....0.75W
 V_{CB0}——集电极—基极电压..... 40V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压..... 20V
 V_{EB0}——发射极—基极电压..... 7V
 I_C——集电极电流..... 5A

电参数 (T_a=25)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{CB0}	集电极—基极截止电流			100	nA	V _{CB} =10V, I _E =0
I _{EB0}	发射极—基极截止电流			100	nA	V _{EB} =7V, I _C =0
V _{CEO}	集电极-发射极电压	20			V	I _C =1mA, I _B =0
V _{EB0}	发射极-基极电压	7			V	I _E =10 μA, I _C =0
h _{FE1}	直流电流增益	180		800		V _{CE} =2V, I _C =0.5A
h _{FE2}	直流电流增益	150				V _{CE} =2V, I _C =2A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			1	V	I _C =3A, I _B =0.1A
f _T	特征频率	150			MHz	V _{CB} =6V, I _E =50mA
C _{ob}	共基极输出电容			50	pF	V _{CB} =20V, I _E =0, f=1MHz